

2013年3月期 第2四半期（2012年4月～9月） 東京エレクトロン 決算説明会

内容：

➤ 第2四半期連結決算の概要

取締役執行役員 原田 芳輝

➤ 2013年3月期業績予想修正 および
重点施策の進捗状況

代表取締役社長 竹中 博司

2012年10月31日

第2四半期 連結決算の概要

取締役執行役員 原田 芳輝

2012年10月31日

業績ハイライト 2012年4月～9月(6か月累計)

売上高	2,666 億円	前下期比 - 13.1% (前年同期比 -18.3%)
営業利益 営業利益率	122 億円 4.6%	前下期比 - 48.3% (前年同期比 -66.9%)
当期純利益	60 億円	前下期比 - 39.5% (前年同期比 -77.2%)

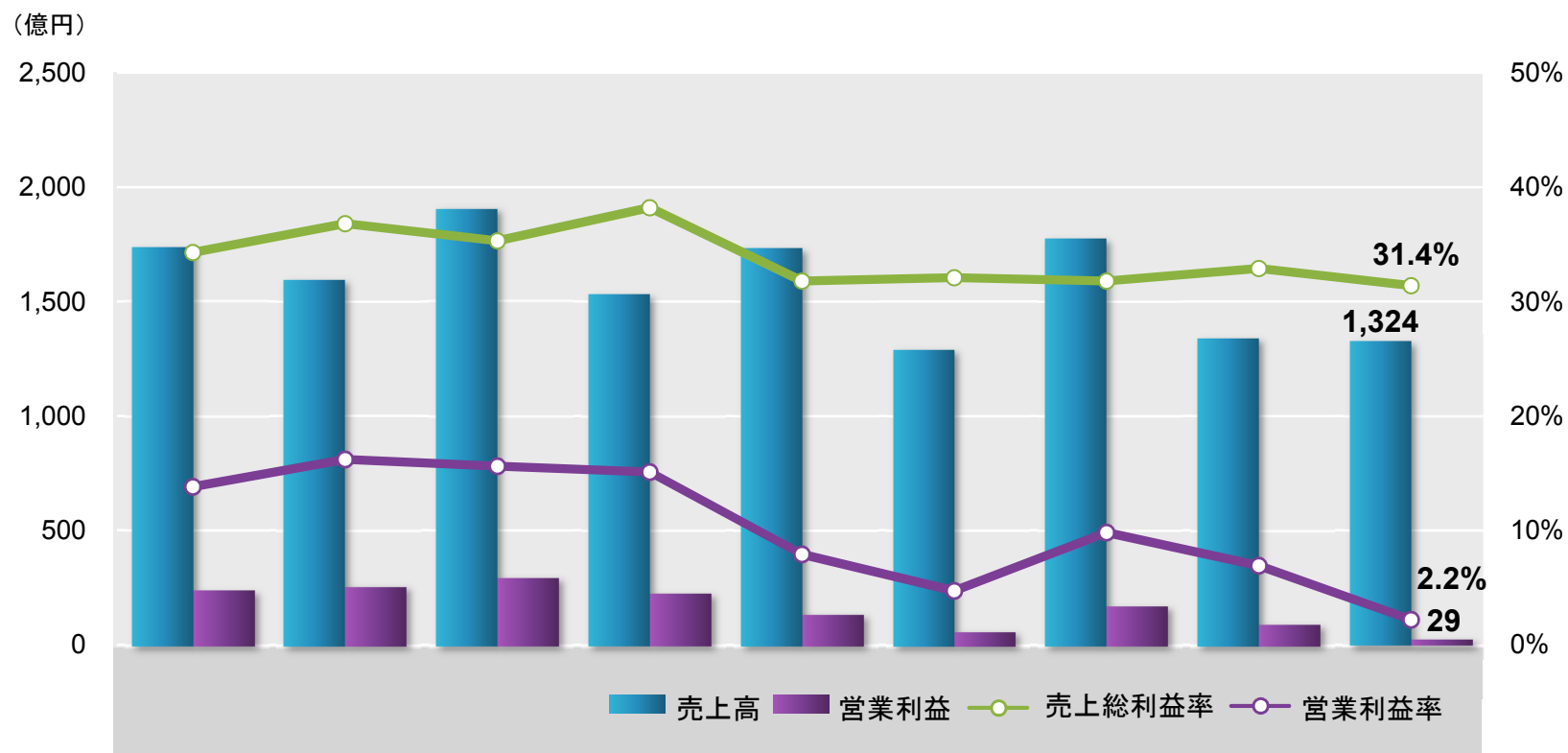
損益状況

(億円)

	2012年3月期		2013年3月期	2013年3月期
	上期	下期	上期	上期(7/30予想)
売上高	3,263	3,067	2,666	2,680
SPE	2,483	2,294	2,146	2,160
FPD/PVE	366	332	92	90
EC/CN	410	438	424	430
その他	2	2	2	-
売上総利益	1,135 (34.8%)	979 (31.9%)	856 (32.1%)	-
販管費	766	743	734	-
営業利益	368 (11.3%)	235 (7.7%)	122 (4.6%)	95 (3.5%)
当期純利益	266	100	60	60
1株当たり 当期純利益(円)	148.85	56.20	33.99	33.49

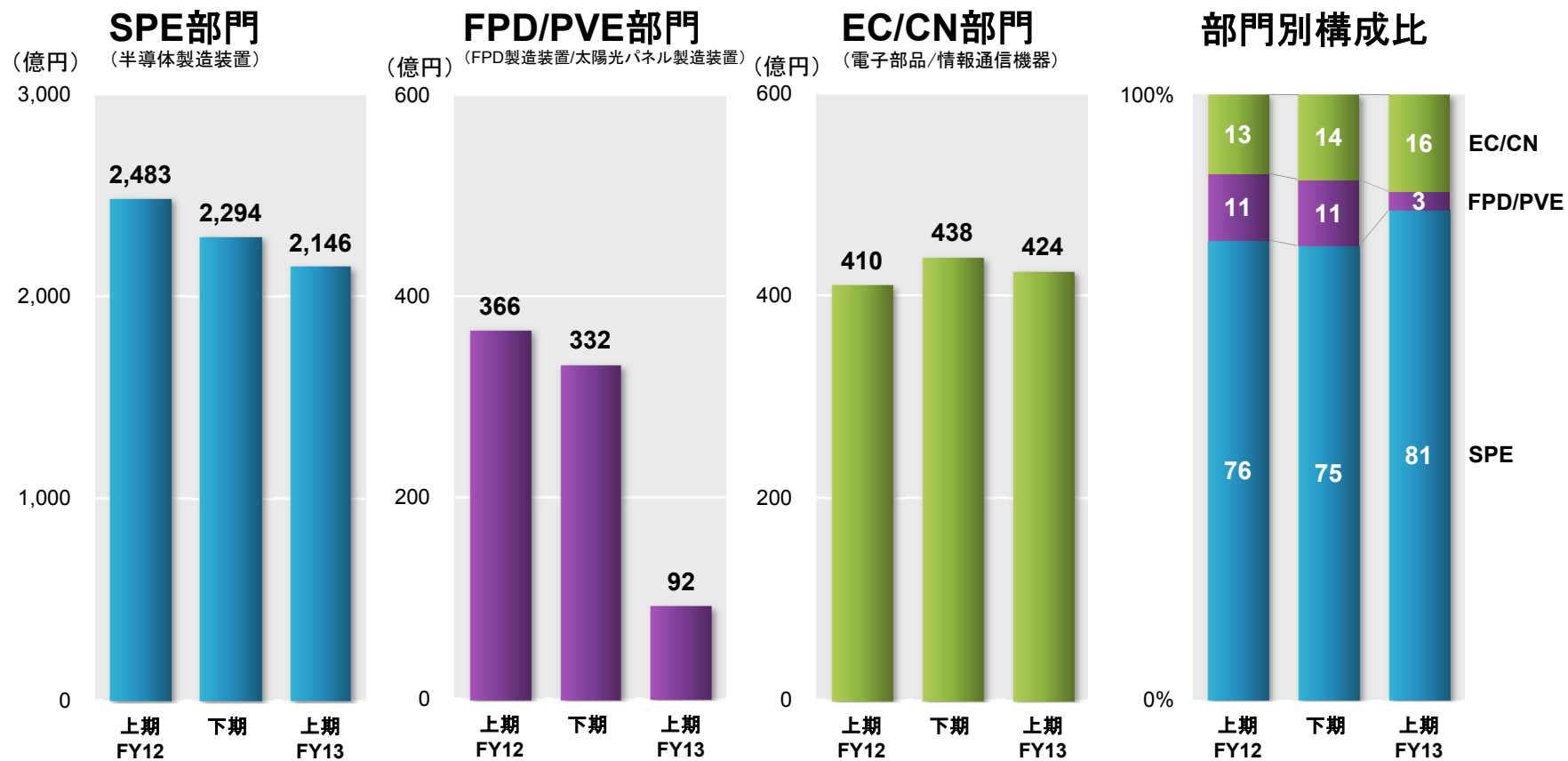
1. SPE:半導体製造装置, FPD/PVE:FPD製造装置/太陽光パネル製造装置, EC/CN:電子部品/情報通信機器
2. ()内は利益率
3. 利益率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

売上高・営業利益・利益率推移

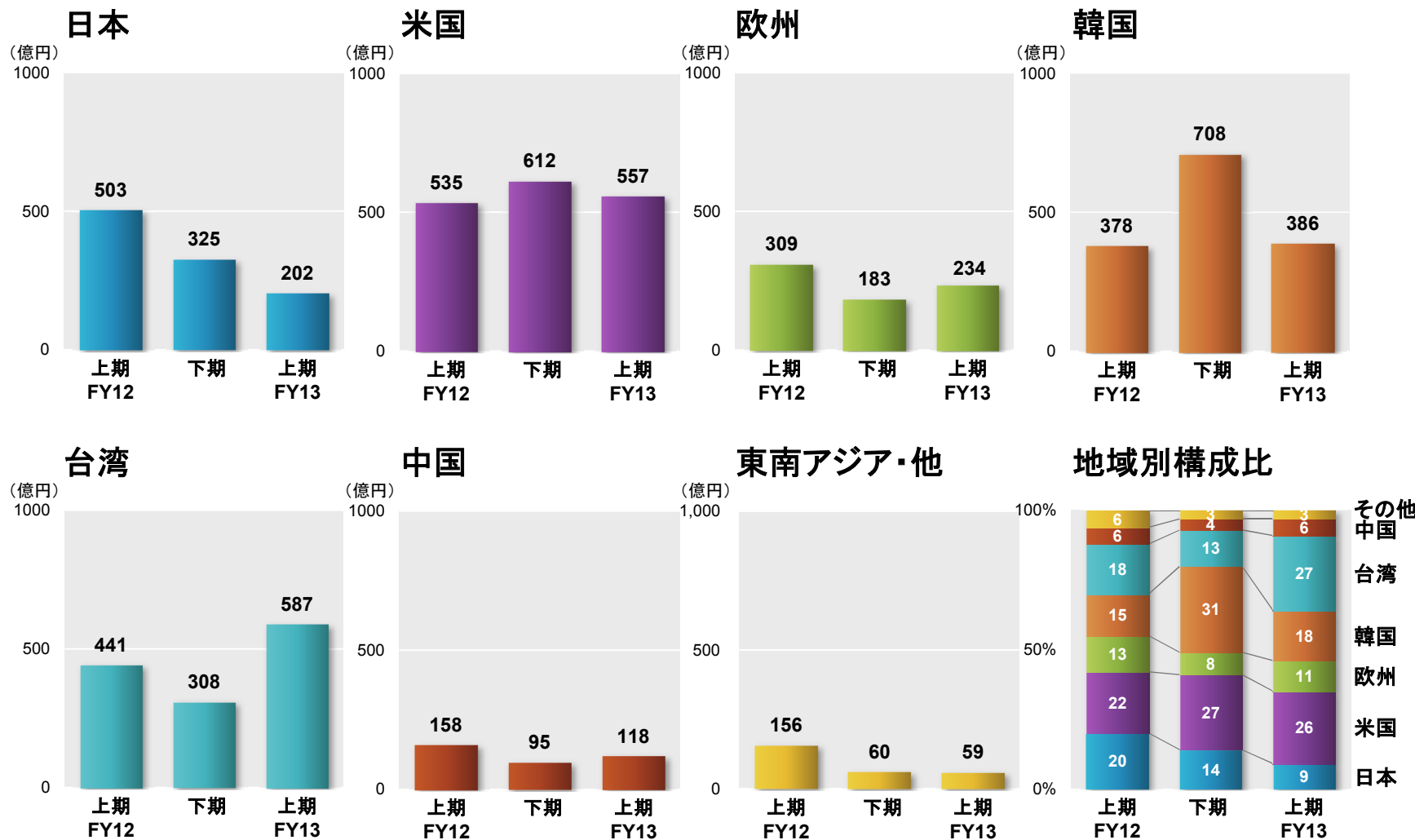


	FY11/2Q	3Q	4Q	FY12/1Q	2Q	3Q	4Q	FY13/1Q	2Q
売上高	1,735	1,596	1,906	1,531	1,732	1,291	1,775	1,341	1,324
営業利益	240	258	297	230	137	60	174	92	29
売上総利益率	34.3%	36.8%	35.3%	38.2%	31.8%	32.1%	31.8%	32.9%	31.4%
営業利益率	13.8%	16.2%	15.6%	15.1%	7.9%	4.7%	9.8%	6.9%	2.2%

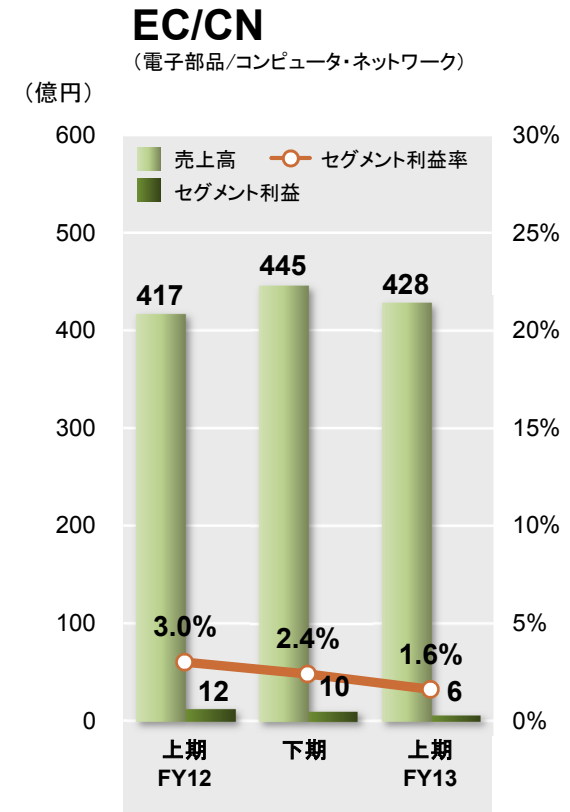
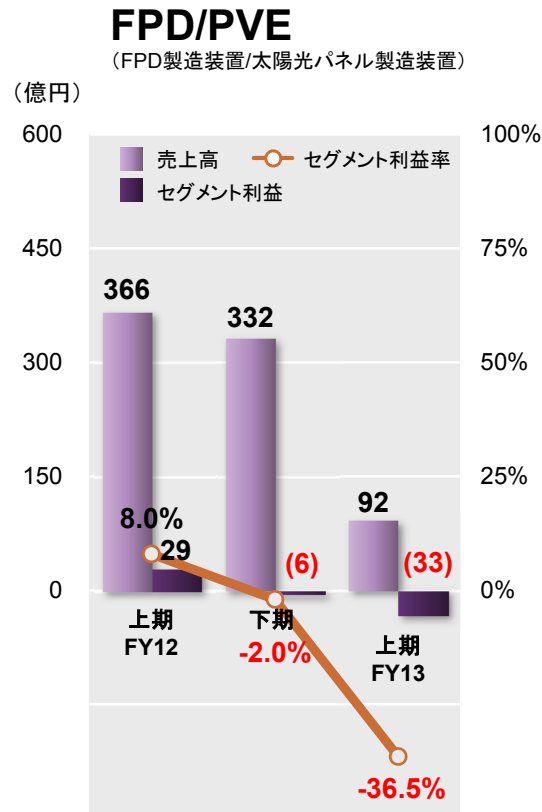
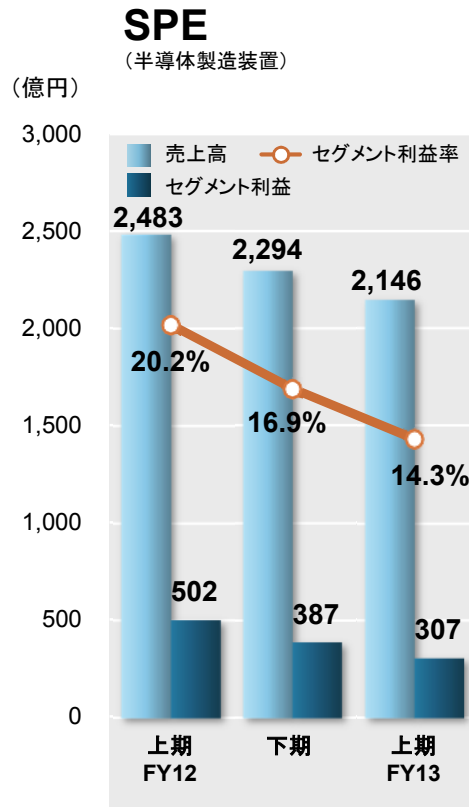
部門別売上高



SPE部門地域別売上高

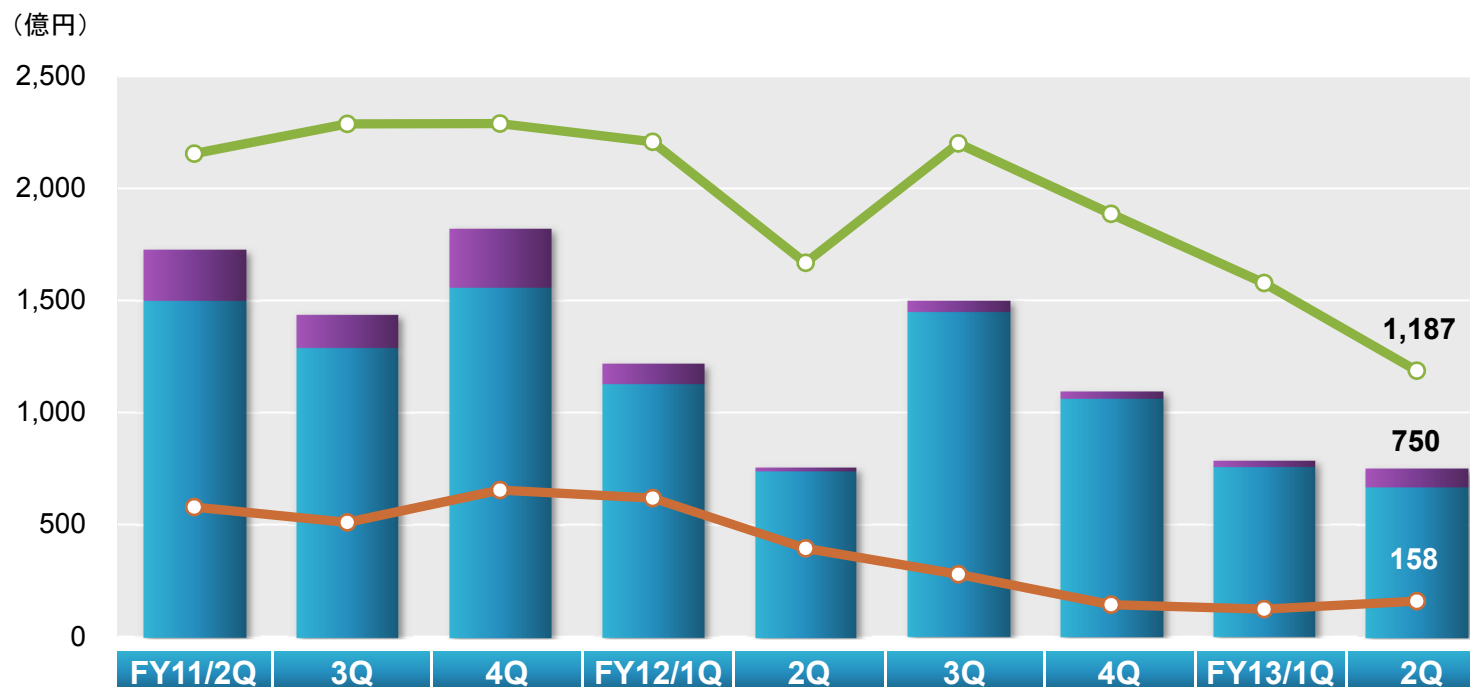


セグメント情報



1. 上記報告セグメントには、基礎研究又は要素研究等の研究開発費が含まれておりません。
2. セグメント利益は、税前利益をベースとしています。
3. 利益率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

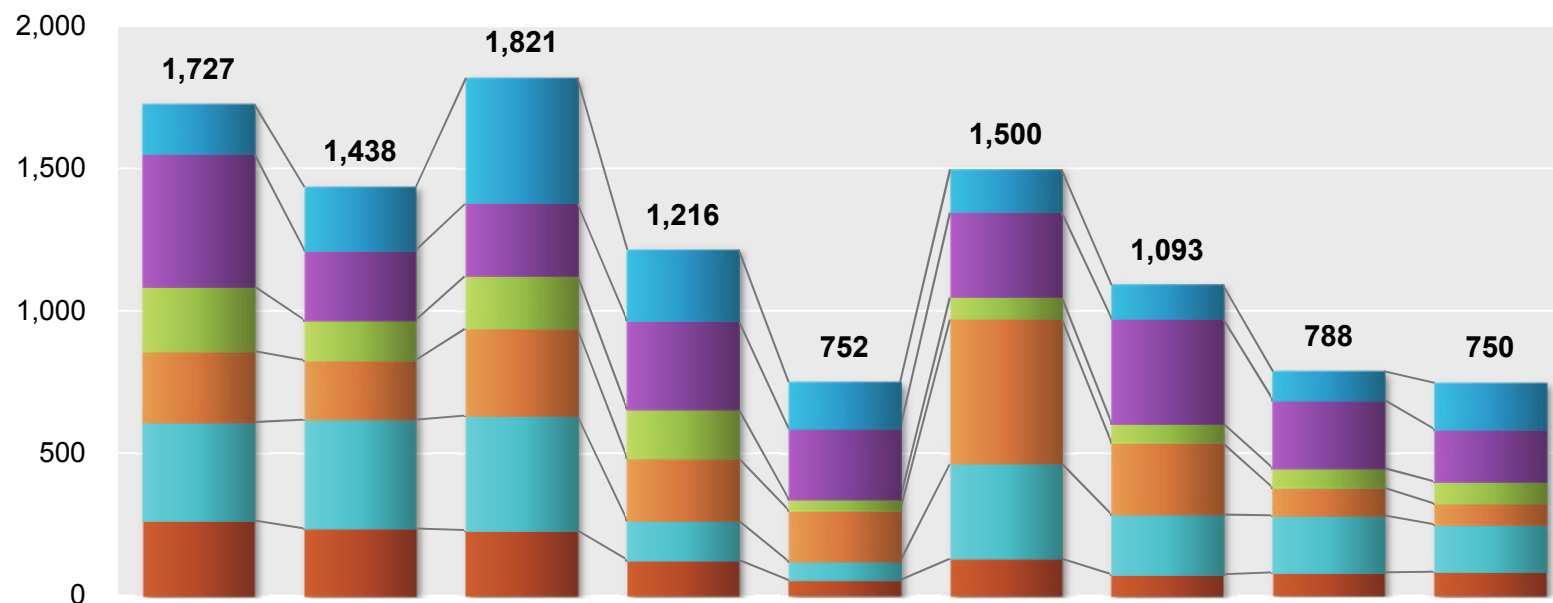
受注額・受注残高



■ 半導体製造装置受注額	1,502	1,286	1,558	1,126	735	1,449	1,064	760	669
■ FPD/PV製造装置受注額	224	152	263	89	17	50	28	28	80
○ 半導体製造装置受注残高	2,155	2,288	2,289	2,207	1,667	2,201	1,886	1,577	1,187
○ FPD/PV製造装置受注残高	578	510	654	618	394	278	142	122	158

地域別受注額：SPE, FPD/PVE

(億円)

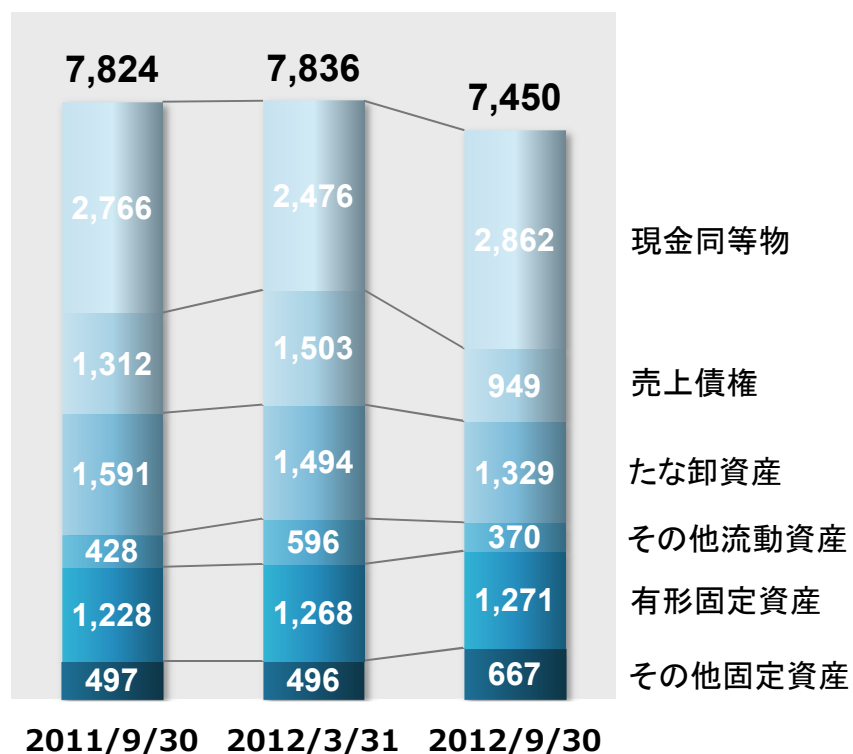


	FY11/2Q	3Q	4Q	FY12/1Q	2Q	3Q	4Q	FY13/1Q	2Q
国内	173	222	439	250	163	149	117	100	163
米国	466	245	254	311	248	297	368	240	184
欧州	228	141	186	172	39	76	70	68	77
韓国	249	210	307	219	179	511	251	97	73
台湾	346	382	403	137	66	335	210	200	167
中国・東南ア他	263	235	229	125	54	129	74	81	83

貸借対照表

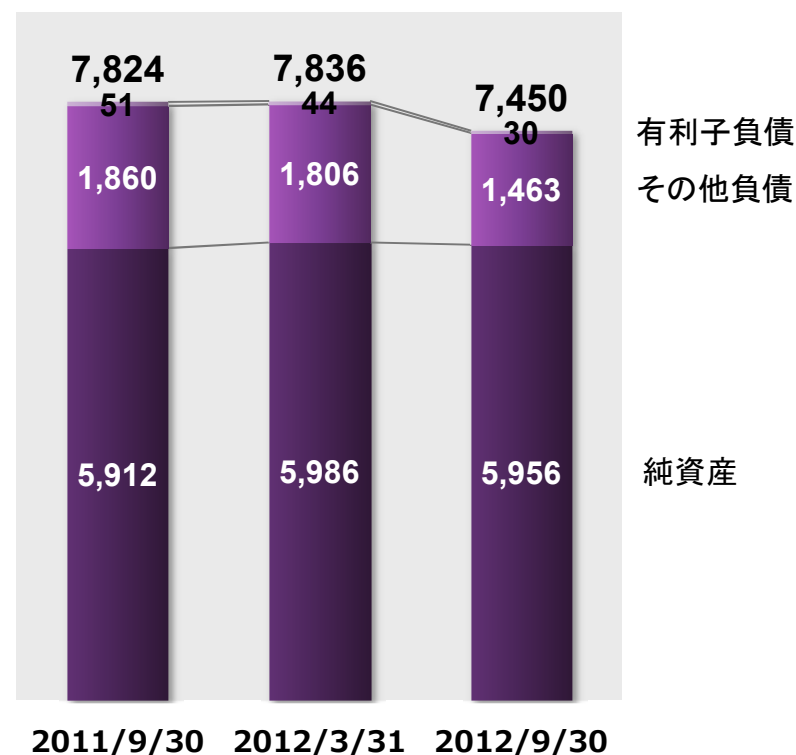
資産

(億円)



負債・純資産

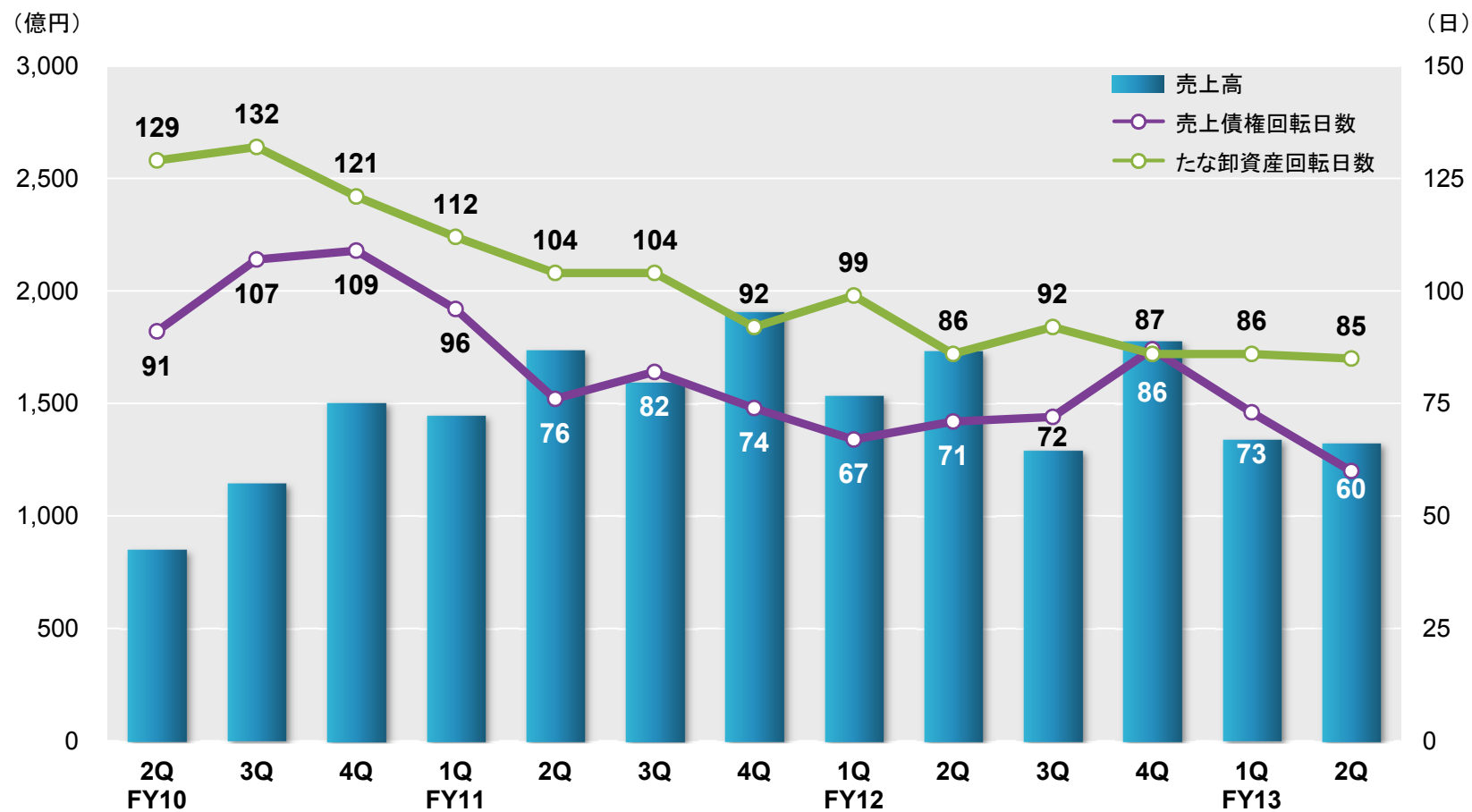
(億円)



2012/9/30その他固定資産667億円には、企業買収等に伴うのれん151億円(暫定)が含まれています。

現金同等物: 現預金 + 短期投資等 (貸借対照表上の表示は有価証券)

たな卸資産・売上債権の回転日数



* 回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365

キャッシュ・フロー

(億円)

	2012年3月期		2013年3月期
	上期	下期	上期
営業キャッシュ・フロー	267	30	739
投資キャッシュ・フロー	-724	641	-842
企業買収に伴う 株式取得による支出	-	-	-158
設備投資他	-169	-223	-126
3か月超の預金等の増減額	-554	864	-557
財務キャッシュ・フロー	-167	-105	-64
現金及び現金同等物の 期末残高	1,011	1,587	1,416
現金及び現金同等物＋ 3か月超の定期預金及び 短期投資等の期末残高	2,766	2,476	2,862

補足資料

損益状況

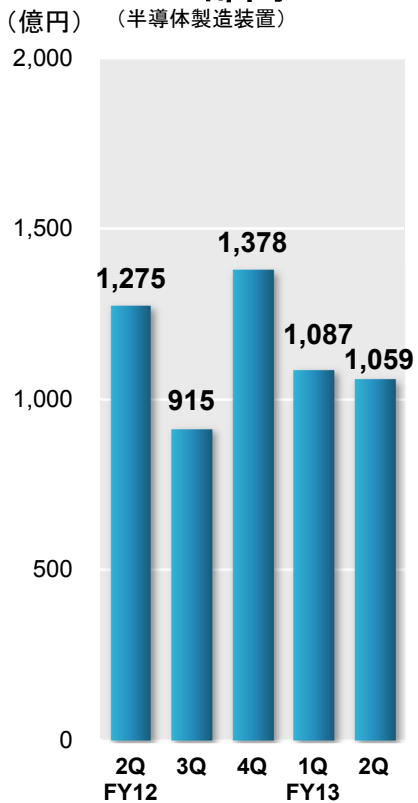
(億円)

	2012年3月期				2013年3月期	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
売上高	1,531	1,732	1,291	1,775	1,341	1,324
SPE	1,208	1,275	915	1,378	1,087	1,059
FPD/PVE	125	241	166	165	47	44
EC/CN	196	213	208	229	206	218
その他	0	1	0	1	1	1
売上総利益	584 (38.2%)	550 (31.8%)	414 (32.1%)	564 (31.8%)	441 (32.9%)	415 (31.4%)
販管費	353	413	353	389	348	386
営業利益	230 (15.1%)	137 (7.9%)	60 (4.7%)	174 (9.8%)	92 (6.9%)	29 (2.2%)
税前利益	234	158	67	146	112	43
当期純利益	166	100	7	93	57	3
1株当たり 当期純利益(円)	92.91	55.95	4.21	51.98	31.93	2.07
研究開発費	181	229	187	216	179	194

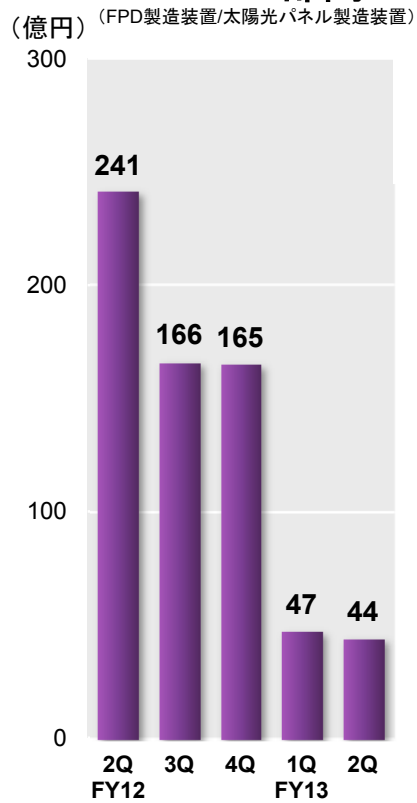
1. SPE: 半導体製造装置, FPD/PVE: FPD製造装置/太陽光パネル製造装置, EC/CN: 電子部品/情報通信機器
2. ()内は利益率
3. 利益率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

部門別売上高

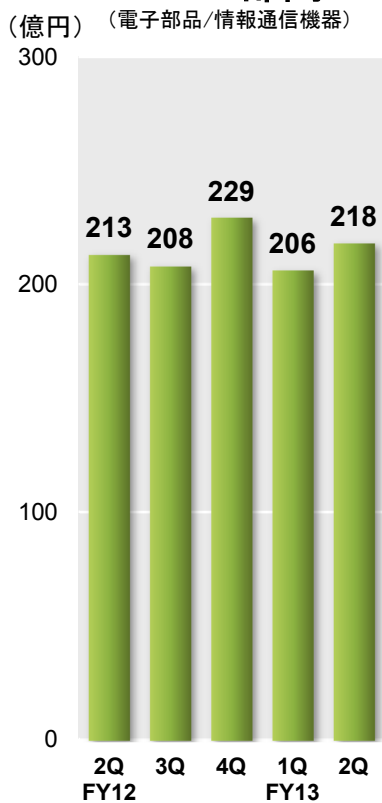
SPE部門
(億円) (半導体製造装置)



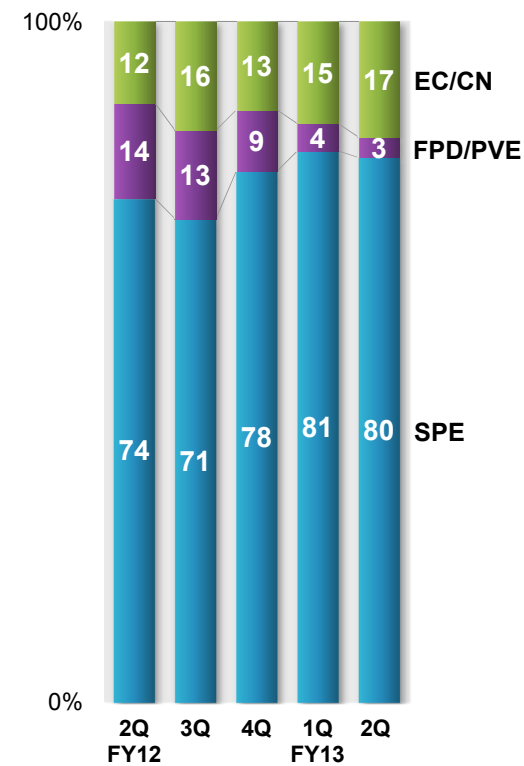
FPD/PVE部門
(億円) (FPD製造装置/太陽光パネル製造装置)



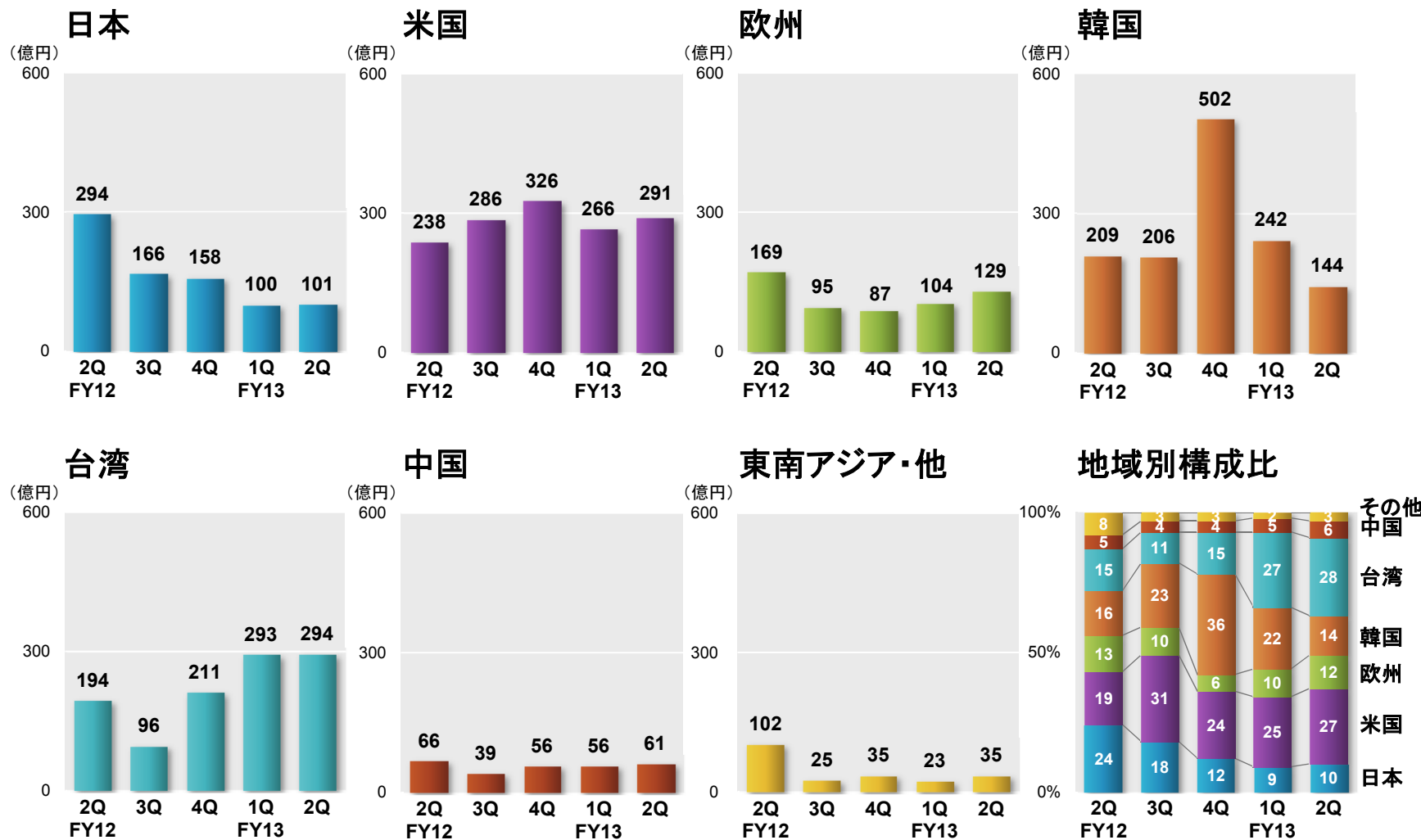
EC/CN部門
(億円) (電子部品/情報通信機器)



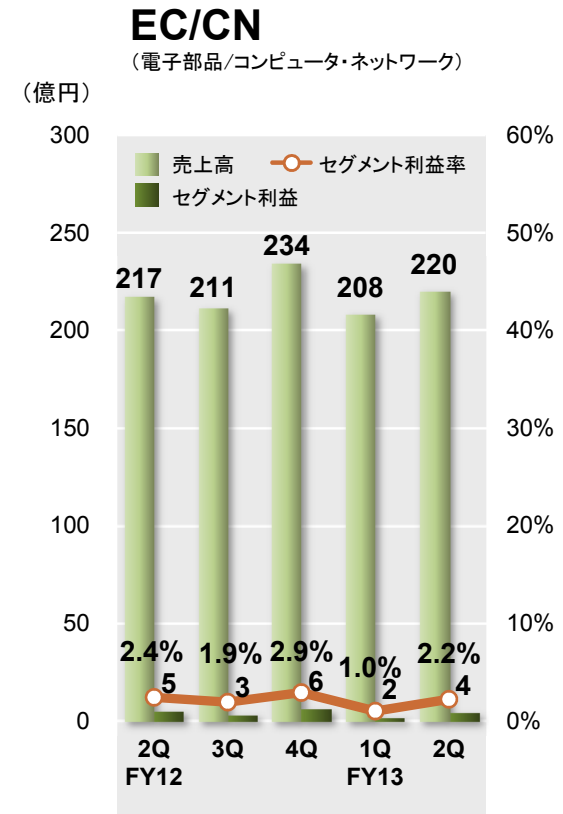
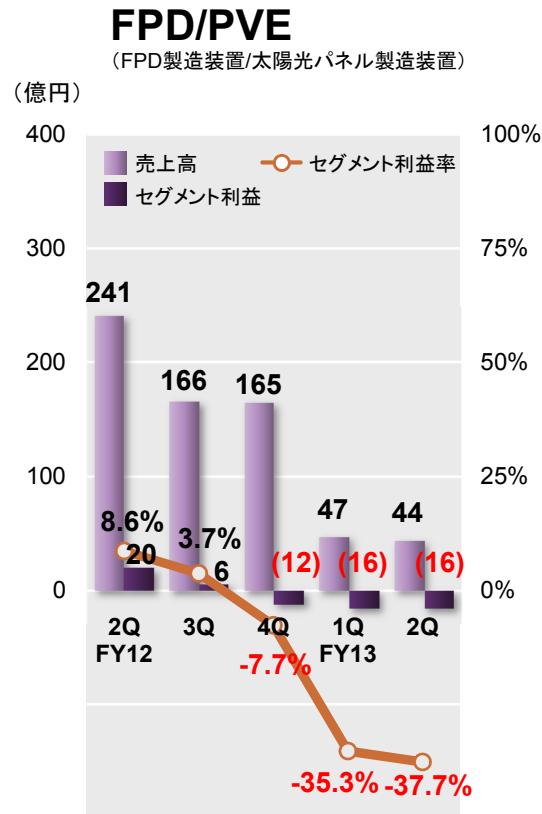
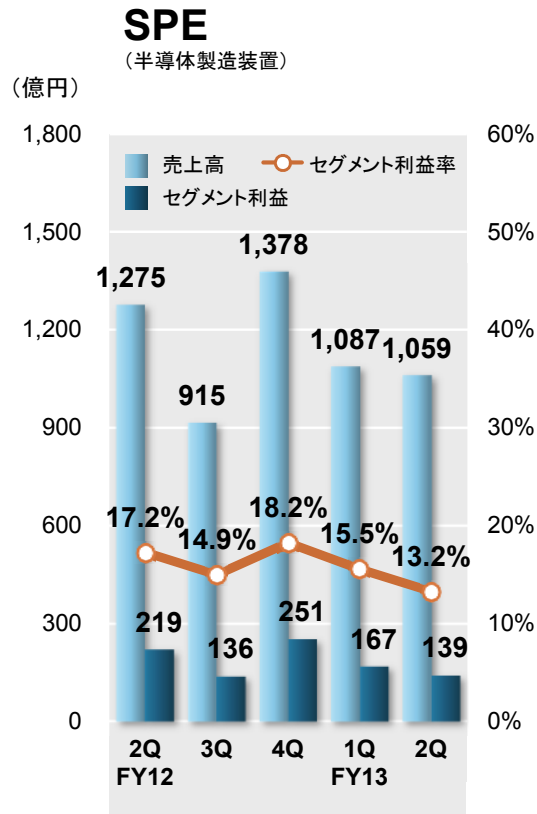
部門別構成比



SPE部門地域別売上高



セグメント情報

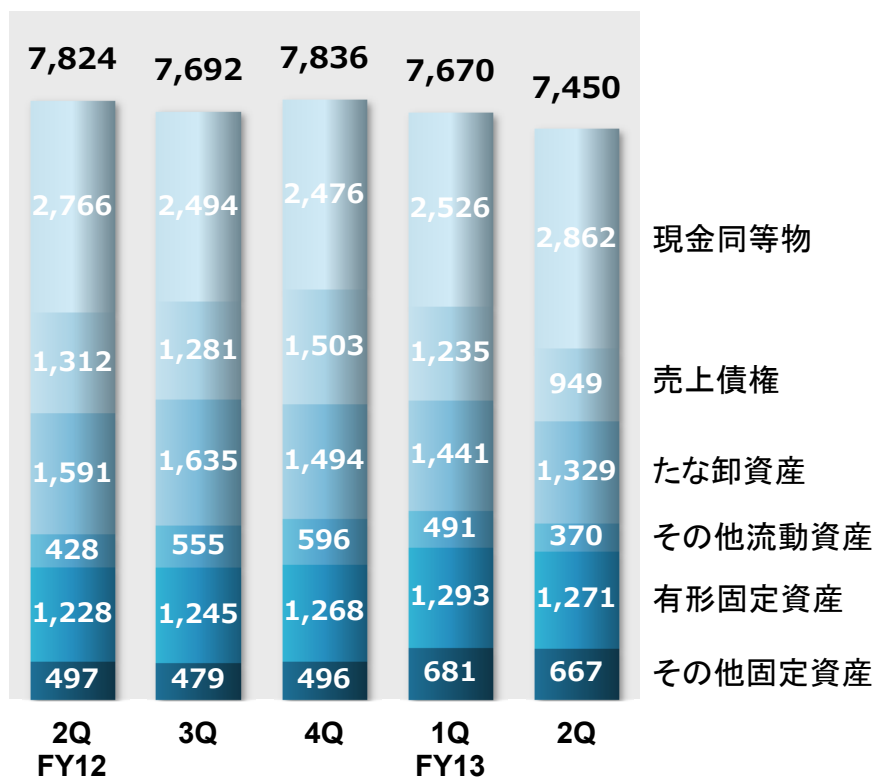


1. 上記報告セグメントには、基礎研究又は要素研究等の研究開発費が含まれておりません。
2. セグメント利益は、税前利益をベースとしています。
3. 利益率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

貸借対照表

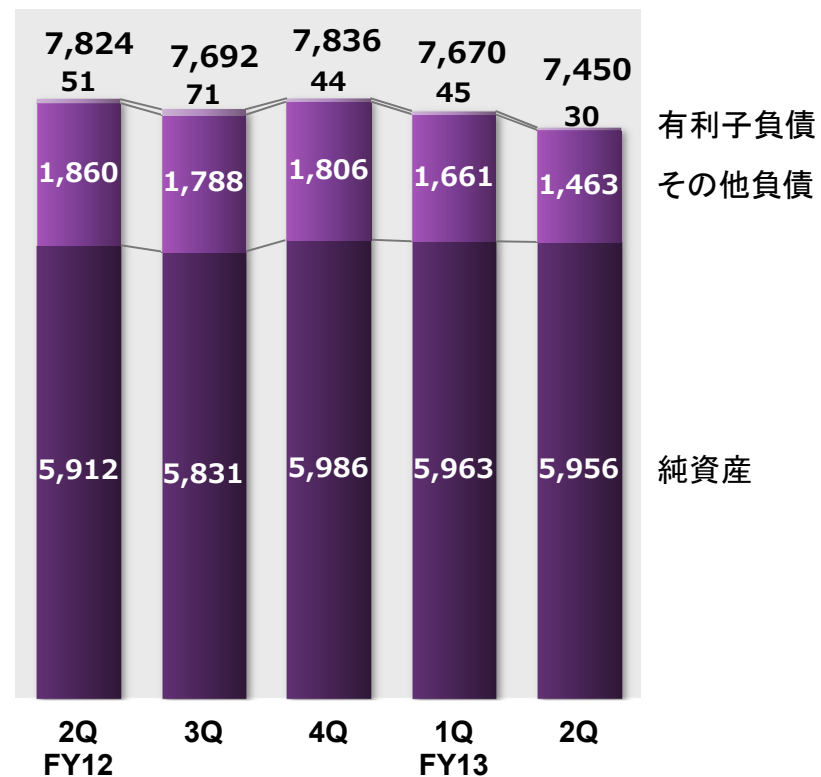
資産

(億円)



負債・純資産

(億円)



2QFY13その他固定資産667億円には、企業買収等に伴うのれん151億円(暫定)が含まれています。

現金同等物: 現預金+短期投資等(貸借対照表上の表示は有価証券)

キャッシュ・フロー

(億円)

	2012年3月期			2013年3月期	
	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
営業キャッシュ・フロー	86	-49	79	358	380
投資キャッシュ・フロー	-137	533	108	-460	-381
企業買収に伴う 株式取得による支出	-	-	-	-158	-
設備投資他	-122	-141	-81	-92	-34
3か月超の預金等の増減額	-14	674	190	-210	-347
財務キャッシュ・フロー	-25	-77	-28	-48	-15
現金及び現金同等物の 期末残高	1,011	1,414	1,587	1,428	1,416
現金及び現金同等物＋ 3か月超の定期預金及び 短期投資等の期末残高	2,766	2,494	2,476	2,526	2,862

2013年3月期業績予想修正および 重点施策の進捗状況

代表取締役社長 竹中 博司

2012年10月31日



TOKYO ELECTRON

CORP IR/October 31, 2012



市場環境



TOKYO ELECTRON

CORP IR/October 31, 2012

50 Years

▶ 半導体設備投資

低調なマクロ経済により、PCやスマートフォンの需要が想定より低迷。ファウンドリー向けの装置需要は比較的堅調だが、CY2012の前工程製造装置市場は前年比マイナス20%程度となる見込み。本格的な回復はCY2013春以降と予想。

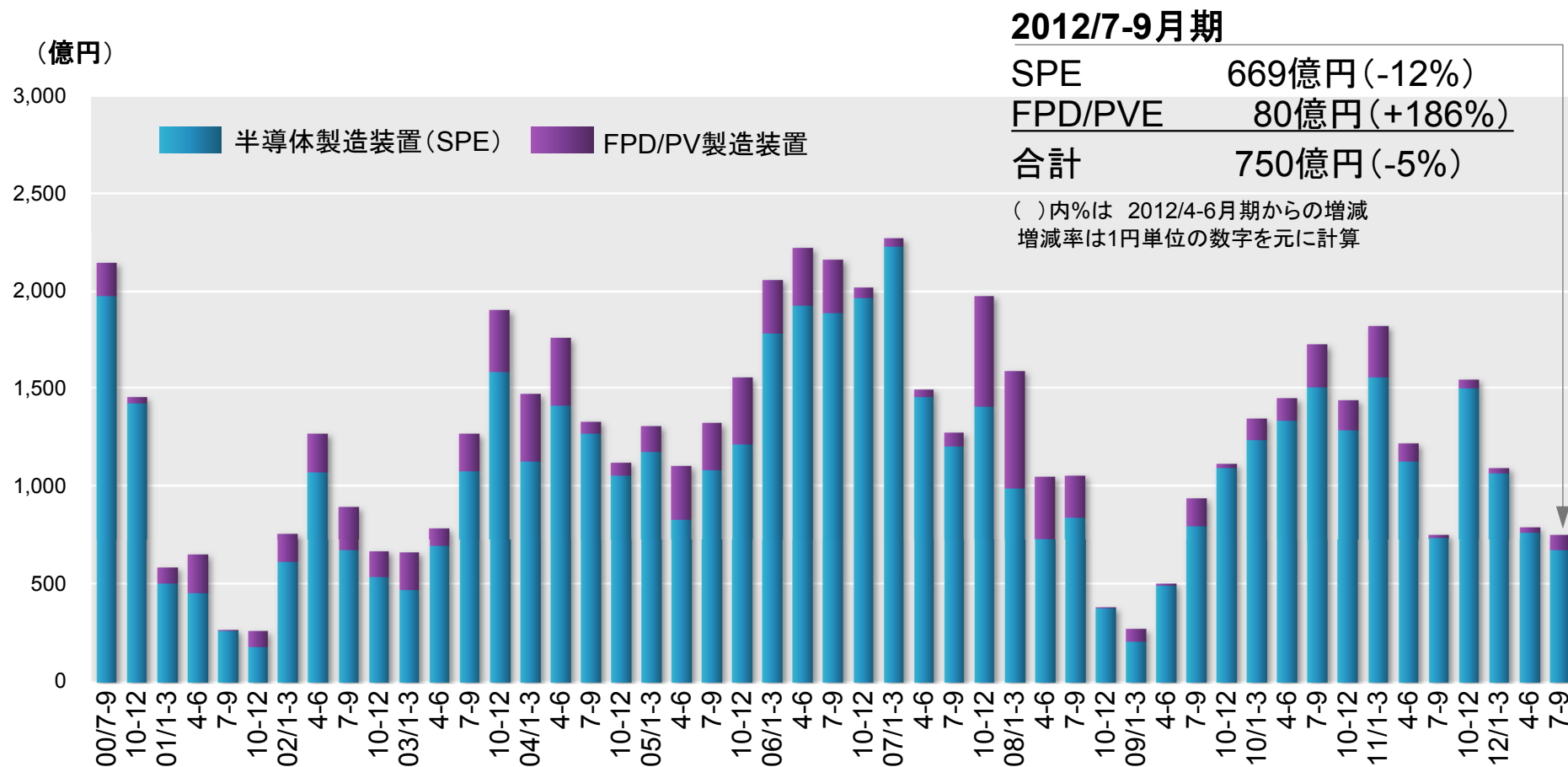
▶ FPD設備投資

TV向け大型パネルは需給バランス改善が見られるが、新規装置需要回復は来年度後半以降。装置需要は、当面中小型パネル向けが中心。

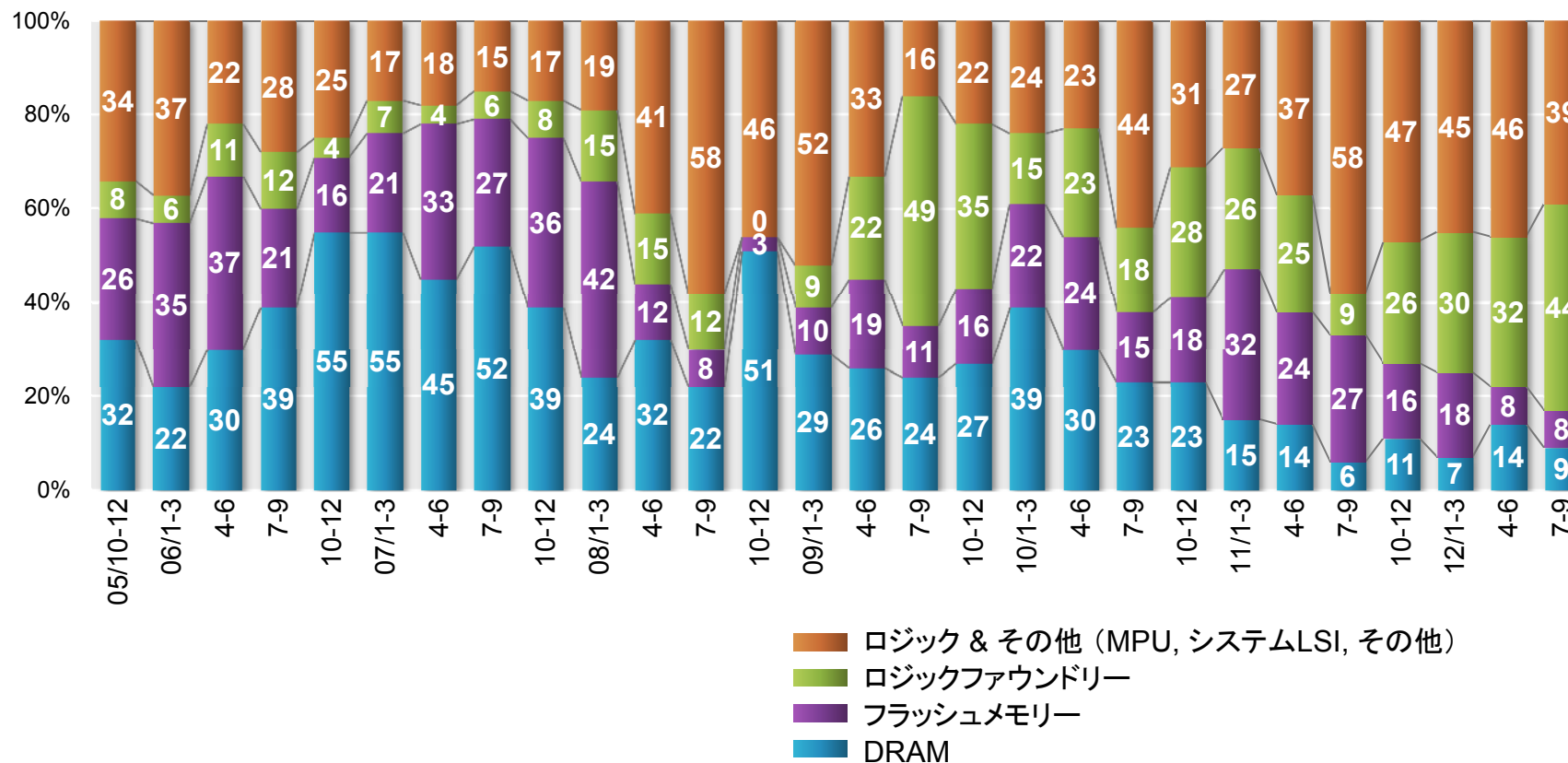
▶ PV設備投資

結晶系の過剰な生産能力は調整過程にあり、足元での設備投資は引き続き低迷。

四半期 受注額



四半期 アプリケーション別SPE受注



- ロジック & その他 (MPU, システムLSI, その他)
- ロジックファウンドリー
- フラッシュメモリー
- DRAM

グラフは装置本体受注における構成比を示しています。

2013年3月期業績予想修正



TOKYO ELECTRON

CORP IR/October 31, 2012



2013年3月期 業績予想修正

(億円)

	FY2012	FY2013					
		上期	下期		通期		通期 対前年 増減
		実績	新予想	修正額*	新予想	修正額*	
売上高	6,330	2,666	2,344	-276	5,010	-290	-21%
SPE	4,778	2,146	1,783	-217	3,930	-230	-18%
FPD/PVE	698	92	97	+7	190	+10	-73%
EC/CN	848	424	460	-70	885	-75	+4%
その他	4	2	2	+2	5	+5	-
営業利益	604	122	3	-102	125	-75	-479
下段: 営業利益率	9.5%	4.6%	0.1%	-3.9pts	2.5%	-1.3pts	-7.0pts
税前利益	606	155	25	-105	180	-75	-426
当期純利益	367	60	10	-70	70	-70	-297

1. SPE: 半導体製造装置 FPD/PVE: フラットパネルディスプレイ及び太陽光パネル製造装置 EC/CN: 電子部品/コンピュータ・ネットワーク
2. 修正額: 7/30に発表した業績予想からの修正額
3. NEXX Systems(買収完了2012/5/1)、FSI International (買収完了2012/10/11)の予想を織り込んでいます。

半導体設備投資停滞でSPE売上が減少

26

業績予想修正に関連して

1. 固定費削減 前期比160億円

- 外注費、人件費、開発費(材料費等)を中心に削減

2. 配当予想

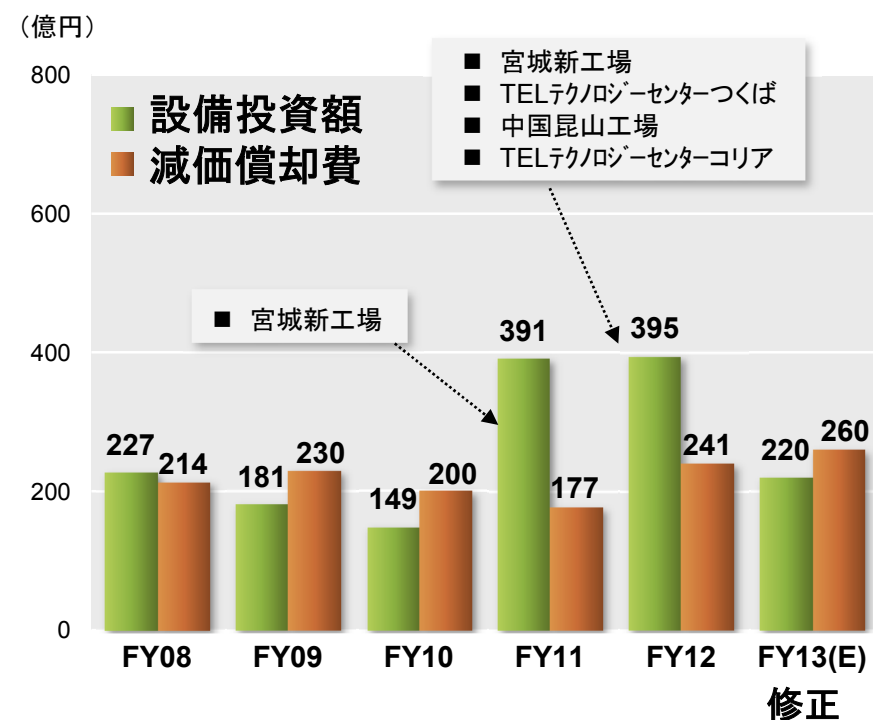
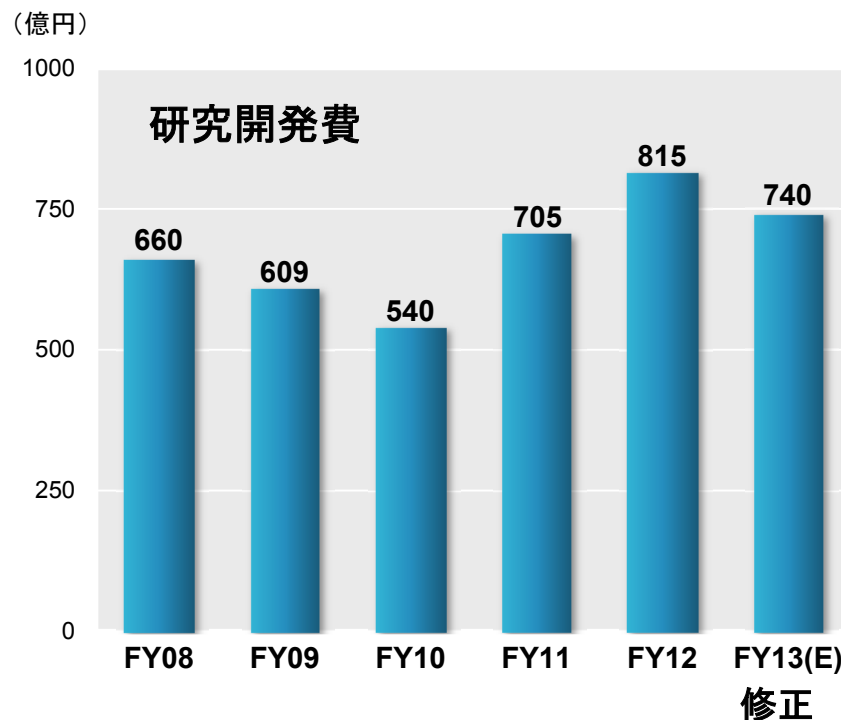
- 記念配当含めた年間配当51円を予定

3. 買収2件完了

	買収発表日	買収完了日	取得価額	のれん(償却年数)
NEXX Systems	2012/3/16	2012/5/1	158億円	153億円(10年)*
FSI International	2012/8/13	2012/10/11	199億円	精査中

*のれんおよび償却年数は暫定値

研究開発費・設備投資額・減価償却費



- 研究開発費：期初計画790億円 → 740億円
- 設備投資額：期初計画240億円 → 220億円
- 減価償却費：期初計画280億円 → 260億円

重点施策に関する当期の進捗

SPE事業の進捗(強化分野)

▶ エッチング装置

➤ 酸化膜市場

ロジック系のBEOL工程及び、メモリー系HARC工程における高シェア維持

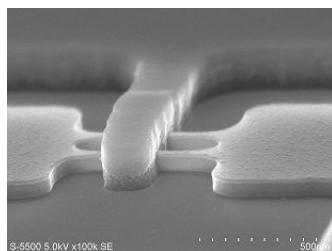
➤ Poly市場

RLSA技術によるロジックFEOL工程での差別化に成功

— 欧米市場で6工程のPOR*を新たに獲得

— アジア市場でも評価装置の導入を実現。来年度以降、数工程獲得の見込み

FinFET



Tactras™ RLSA™ Etch

*POR (Process of Record): 顧客の半導体製造プロセスにおける装置採用の認定

SPE事業の進捗(強化分野)

▶ 洗浄装置

➤ 枚葉洗浄

- 市場評価にてBEOLにおけるプロセス優位性を確認
- 近く数工程の量産POR獲得見通し



CELLESTA™

➤ ドライ洗浄

- Certas™ は高シェア維持
 今後は新材料の適用等で工程拡大を見込む
- 生産性を大幅に改善した新規プラットフォームの開発終了
 2013年市場投入の準備整う



Certas™

➤ 米国 FSI International 買収

- 枚葉SPM処理*技術, ドライパーティクル除去技術での
 製品ラインアップの拡充



ORION™

*SPM (Sulfuric Acid & Hydrogen Peroxide Mixture) 処理: 硫酸と過酸化水素水を混合してさらに加熱することでレジストや金属不純物を除去するプロセス

洗浄装置メーカー米国 FSI Internationalの買収完了

- 買収完了日： 2012年10月11日
- 取得価額： 199億円

FSI買収の狙い

- 枚葉洗浄強化：次世代技術ニーズ獲得
- 補完効果：アプリケーション/獲得市場(顧客)
- 製品ラインアップの拡充

バッチ	枚葉				スクラバー
WET	WET		DRY		WET
EXPEDIUS™ 	CELLESTA™ 	ORION™  高温SPM処理	Certas™ 	ANTARES™  パーティクル除去	NS300+ 
					

FSI製品による補完効果で製品ラインアップ拡充

32

SPE事業 その他ハイライト

▶ 熱処理成膜装置

- 高性能ALD装置(NT333)の顧客評価進む。次世代メモリ向けPOR獲得

▶ 3DI

- 戦略顧客数社のパイロットラインに、TSV用プロセス装置を出荷
(ウェーハボンディング/デボンディング装置, Si深堀エッチング装置, ポリイミド成膜装置)
- C-MOSセンサー向けボンディング装置の出荷好調

▶ 新メモリ STT-MRAM量産化技術(東北大学との共同開発)

- 2015年量産に向けて、各種製造装置の開発開始

FPD/PV事業の進捗

▶ FPD製造装置

- コスト競争力の強化
 - － 人員の再配置による規模の適正化
 - － 中国昆山工場の稼働開始
- 大型ICPエッチャーを酸化物半導体/有機ELバックプレーン向けに販売開始

➤ 有機EL製造装置

市場動向：大型有機ELテレビ用パネルの本格量産は2014年に後ろ倒し
当社状況：蒸着装置に加え、インクジェット装置の顧客評価がスタート

▶ 太陽光パネル製造装置

- Oerlikon Solar社の買収、各国独禁法当局の承認完了。クロージングに向けて協議中

サマリー

1. PCやスマートフォン需要が想定より低迷し、CY2012の半導体前工程製造装置市場は20%程度減少の見込み。下期のSPE売上が減少する見通しとなり、業績予想を下方修正。
2. 調整期への対策として年間160億円の固定費削減を実施。
3. 積極的な開発投資や必要な企業買収などは行い、一層の技術競争力向上を目指す。

▶ 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD/PV市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

▶ 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

▶ 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD/PV製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

FPD/PV:フラットパネルディスプレイ及び太陽電池

